

**关键指标**

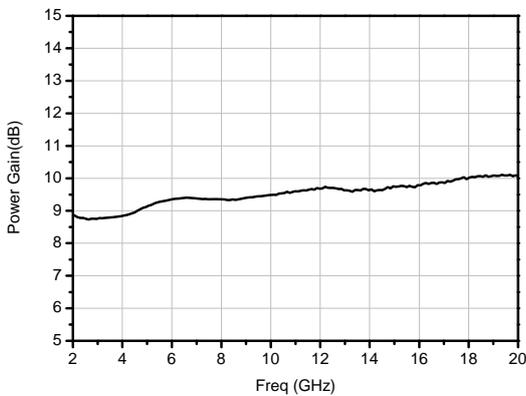
频率: 2~20GHz  
 功率增益: 9.5dB  
 1dB 压缩点输出功率: 28dBm  
 3dB 压缩点输出功率: 29.5dBm  
 电压/电流: +10V/292mA  
 芯片尺寸: 2.6mm×1.4mm

**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+10V, V<sub>g1</sub>=-1.35V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~20		
功率增益(dB)	-	9.5	-
增益平坦度(dB)	-	±0.8	-
输入驻波	-	1.7	-
输出驻波	-	1.4	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	28	-
P-1 功率附加效率	-	17%	-
3dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	29.5	-
P-3 功率附加效率	-	22%	-
静态电流 (mA)	-	292	-

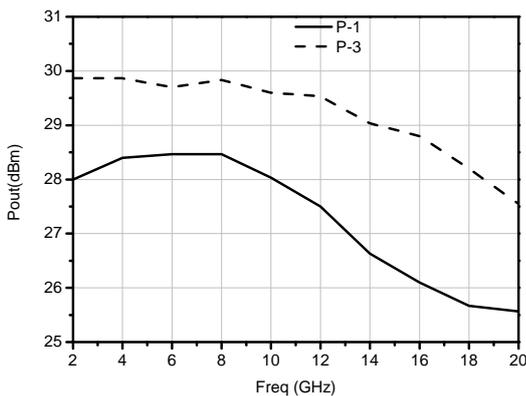
**典型测试曲线 (V<sub>dd</sub>=+10V)**

功率增益



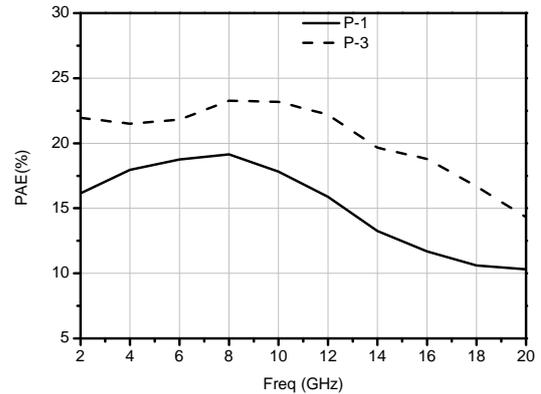
输出功率

(V<sub>dd</sub>=+10V, V<sub>g1</sub>=-1.35V, I<sub>D</sub>=292mA)

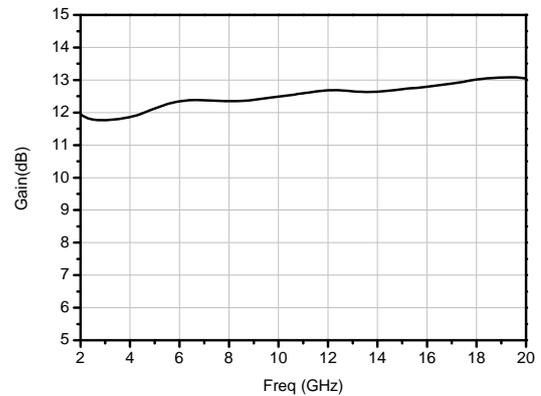


功率附加效率

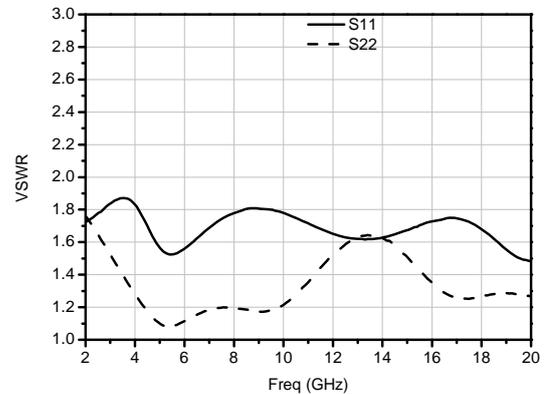
(V<sub>dd</sub>=+10V, V<sub>g1</sub>=-1.35V, I<sub>D</sub>=292mA)



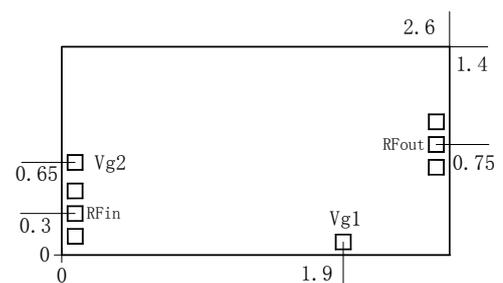
小信号增益



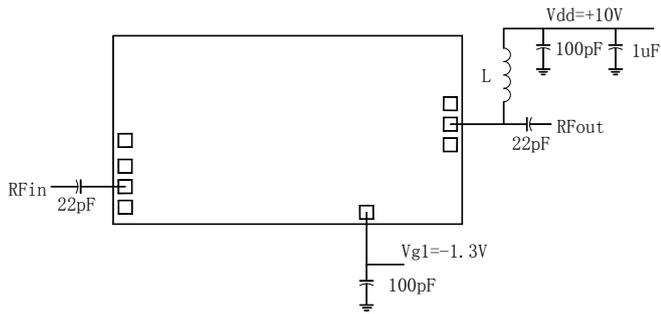
驻波



**外形和端口尺寸 (mm)**



推荐装配图



L: 宽带电感, 推荐型号: CCM19T40-002

绝对额定最大值

工作电压	+12V
最大输入功率	+25dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合, 建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ;
5. 芯片微波端均无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。